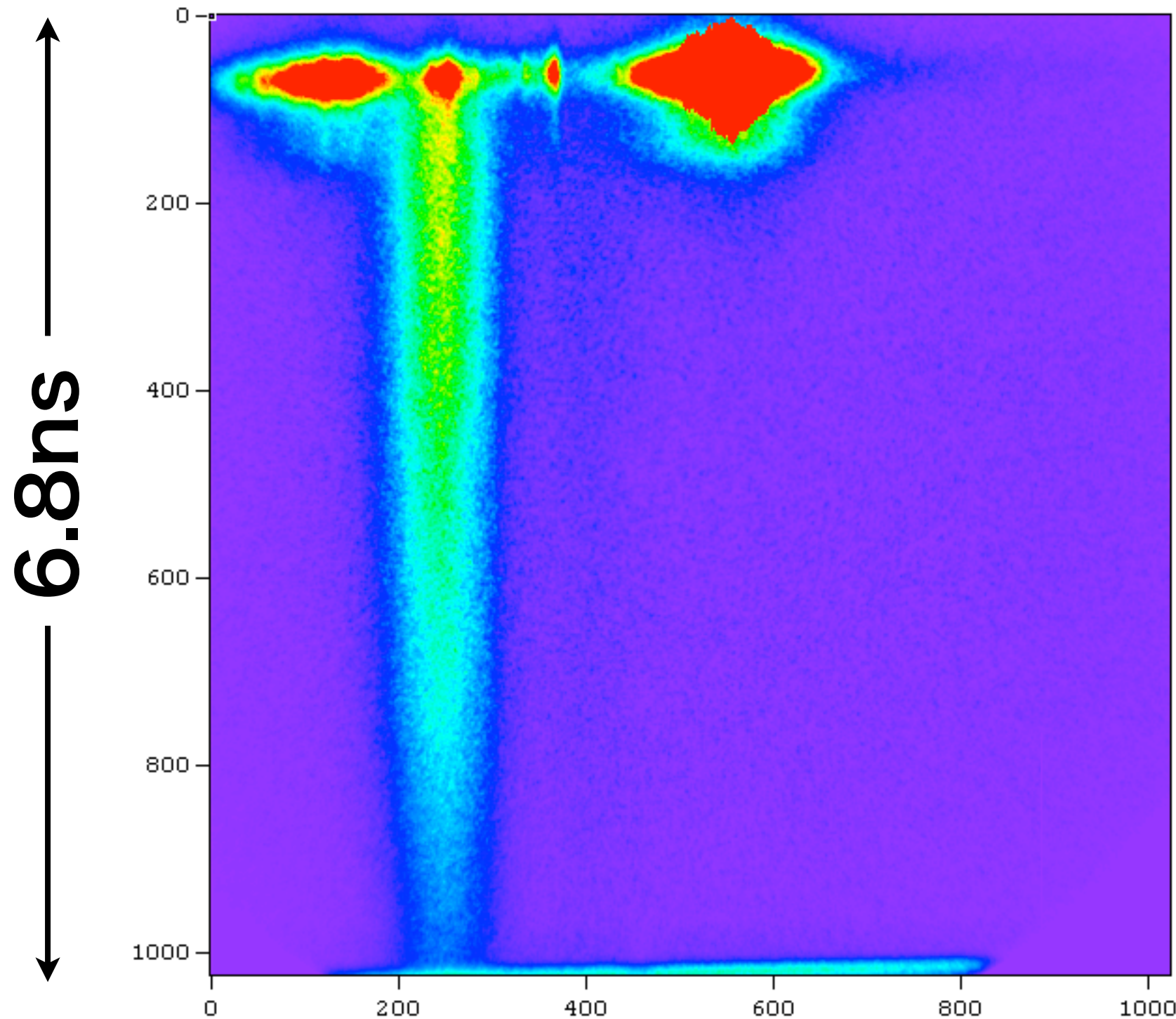


サンプル基板の膜部分をセットした長時間観察



ストリーク条件
ゲイン：40
掃引：5ns
繰返し：1MHz
Slit幅：50 μ m

CCD条件
ゲイン：high
露光：100秒
温度：-70 $^{\circ}$ C

レーザー
繰返し：1MHz
TTL：20ns
コリメータ有り

ストリークスリット面にレーザー光は45度斜入射させており，スリット直前においたサンプル膜が励起され蛍光を出すのが弱いので100秒間(1E8パルス分)CCDで積算した．レーザーパルスは，赤い部分で前スライドと同じタイミング．